Fig. 1

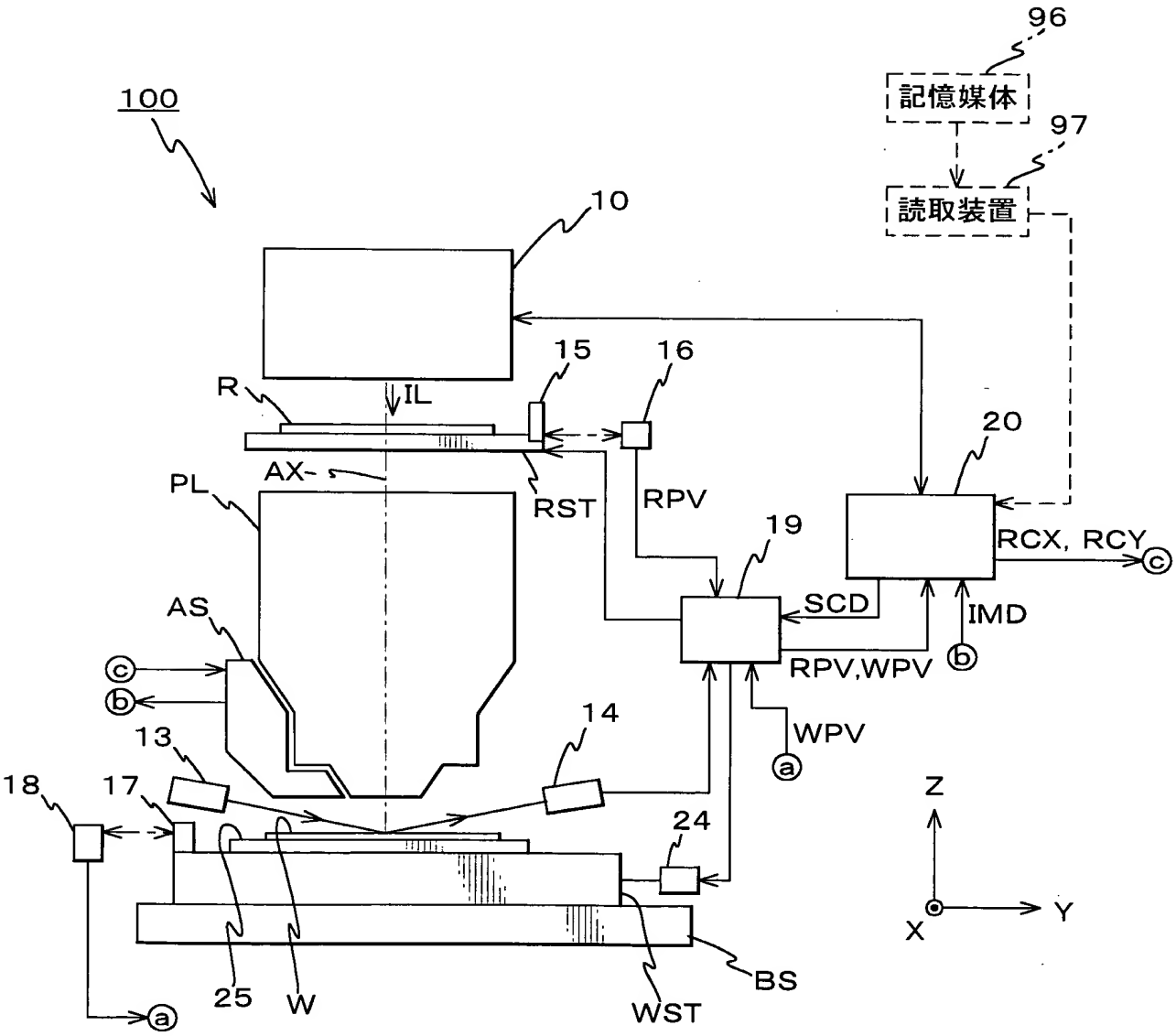


Fig. 2A

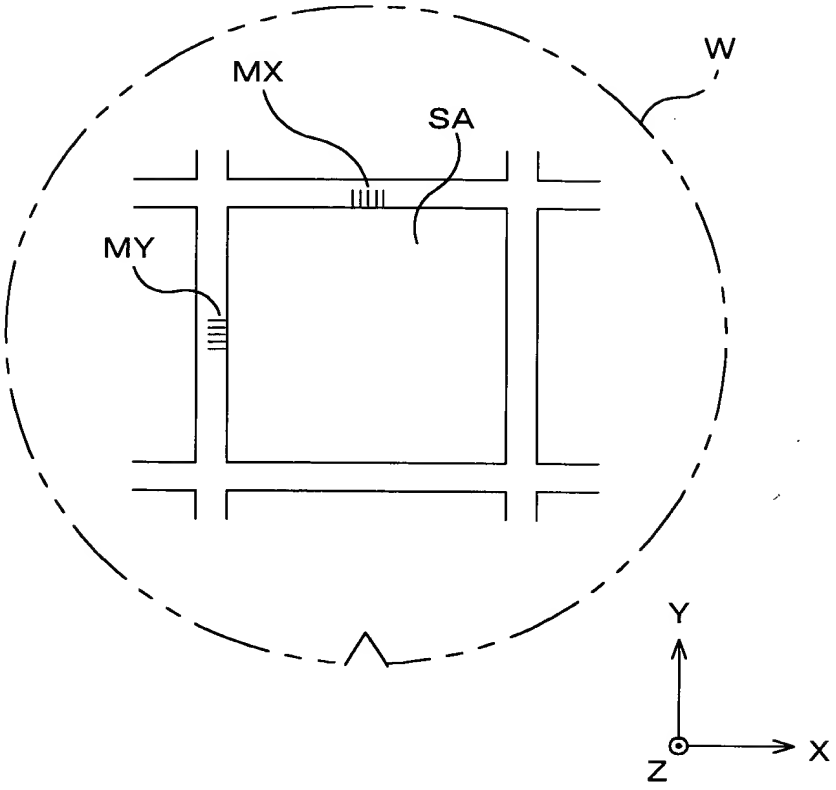


Fig. 2B

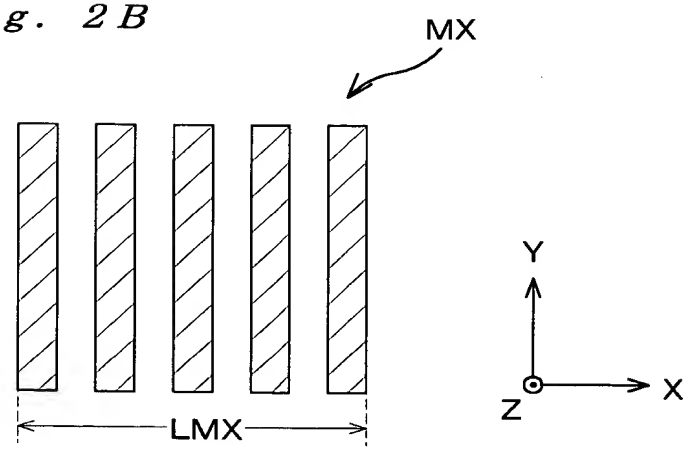


Fig. 3A

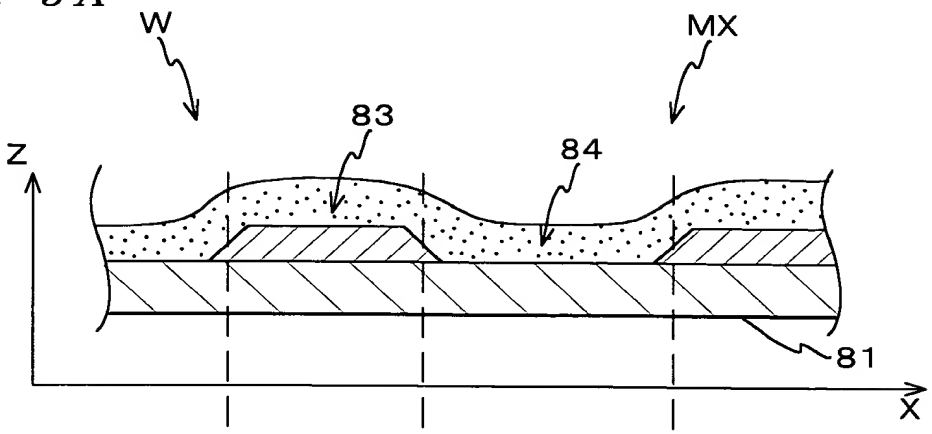


Fig. 3B

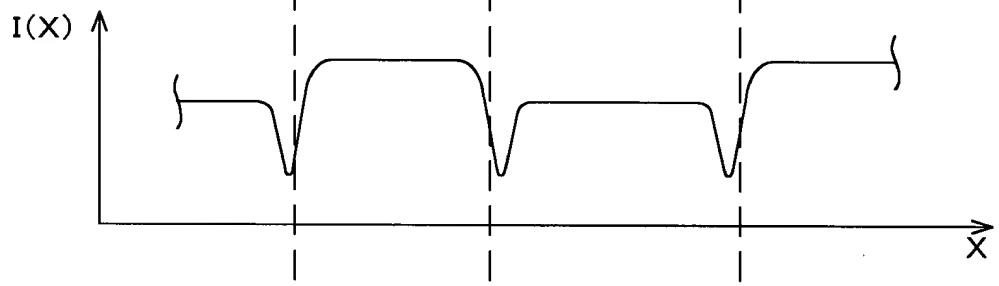


Fig. 3C

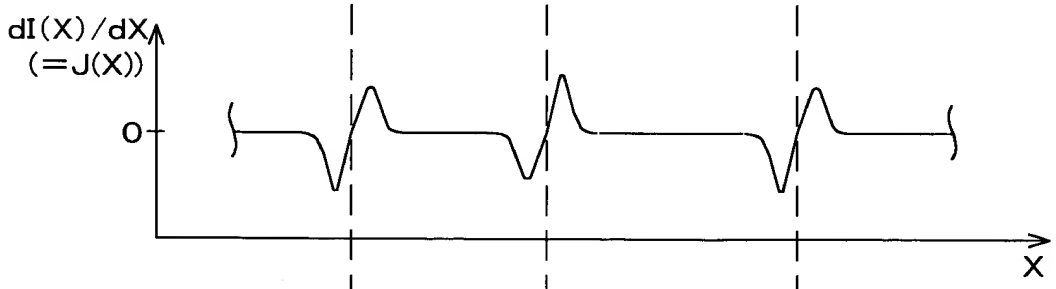


Fig. 3D

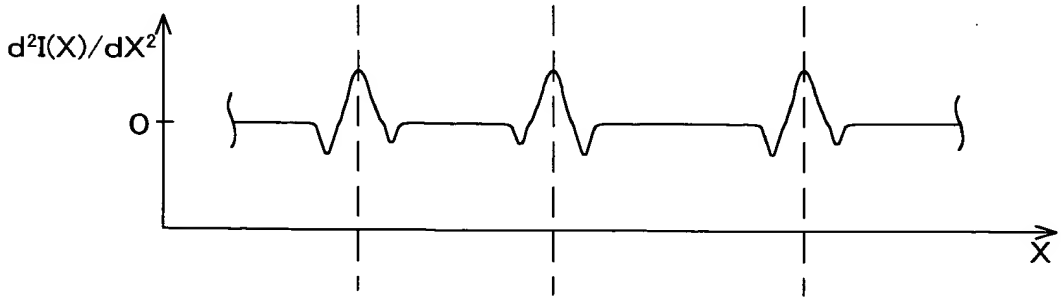


Fig. 4A

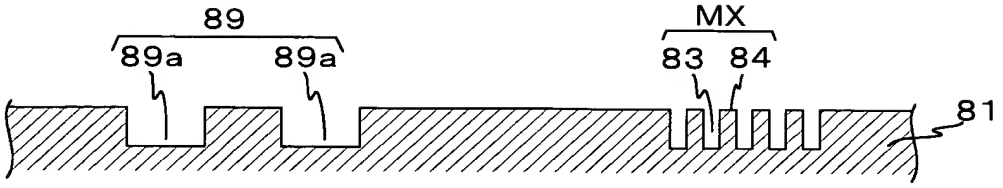


Fig. 4B

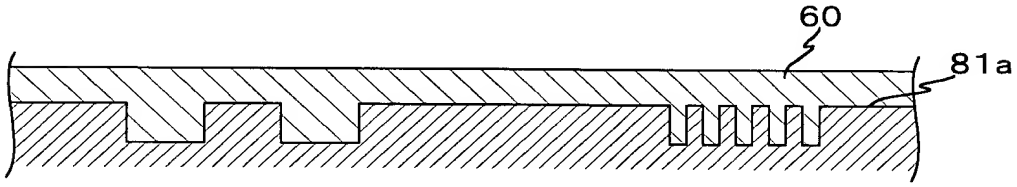


Fig. 4C

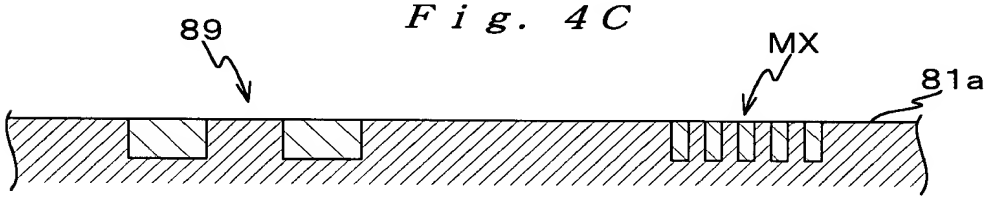


Fig. 4D

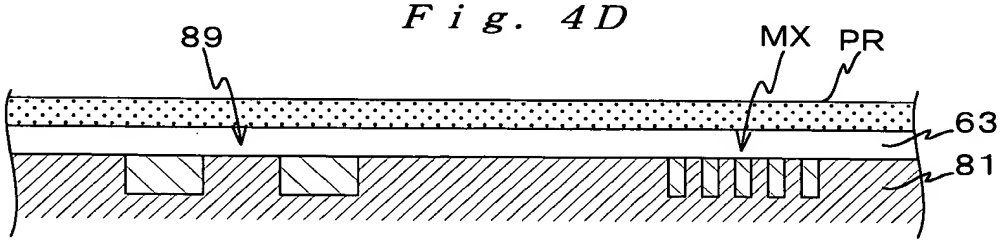


Fig. 4E

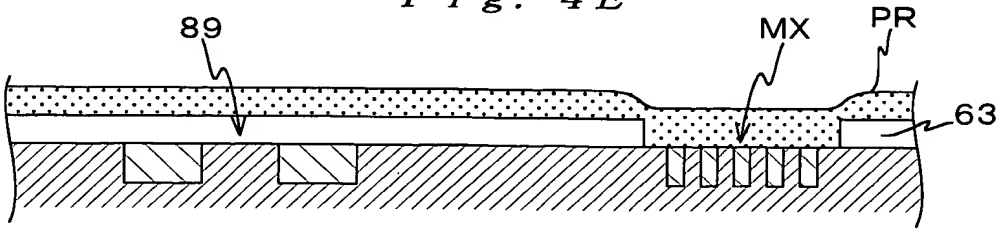


Fig. 5

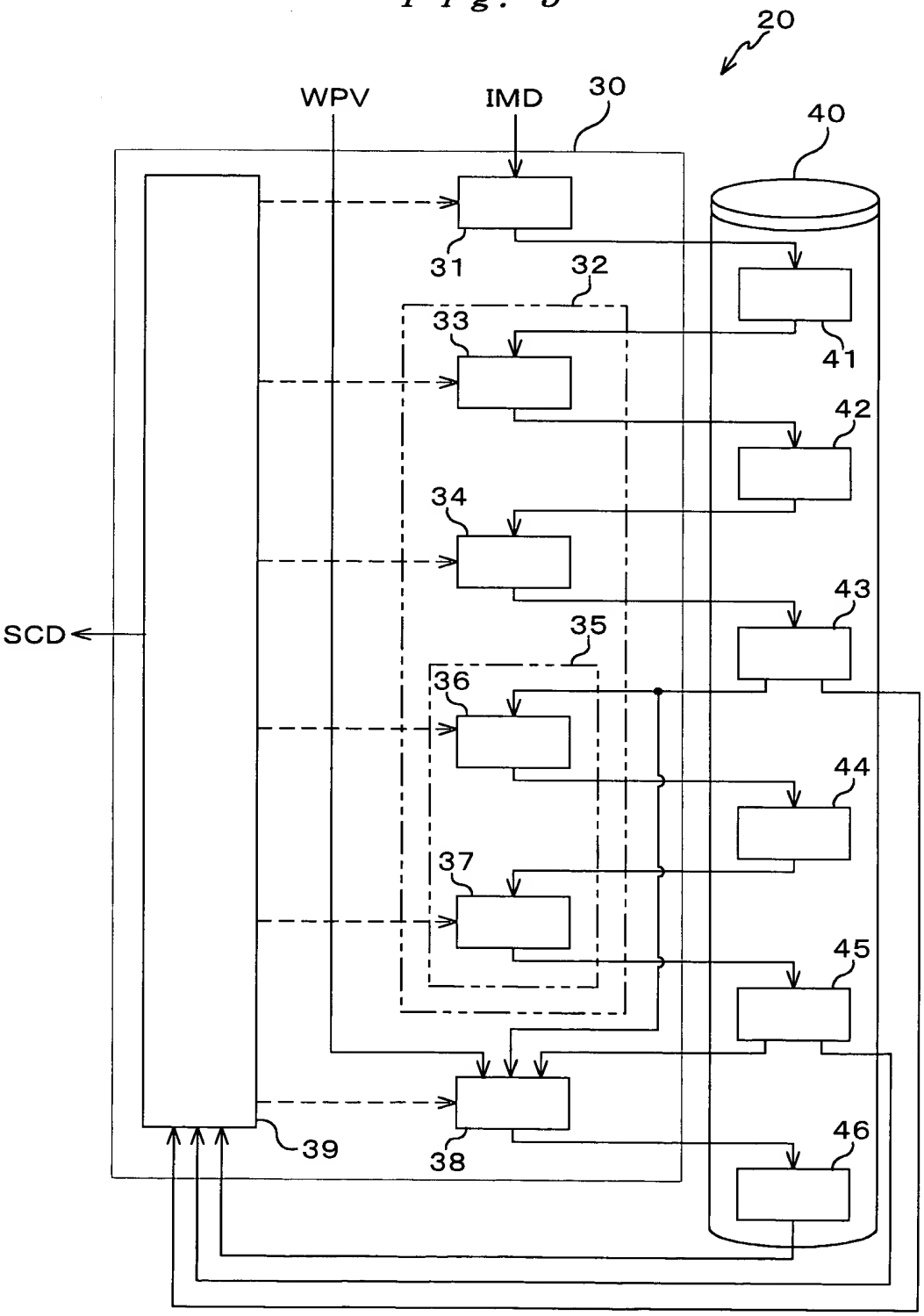


Fig. 6

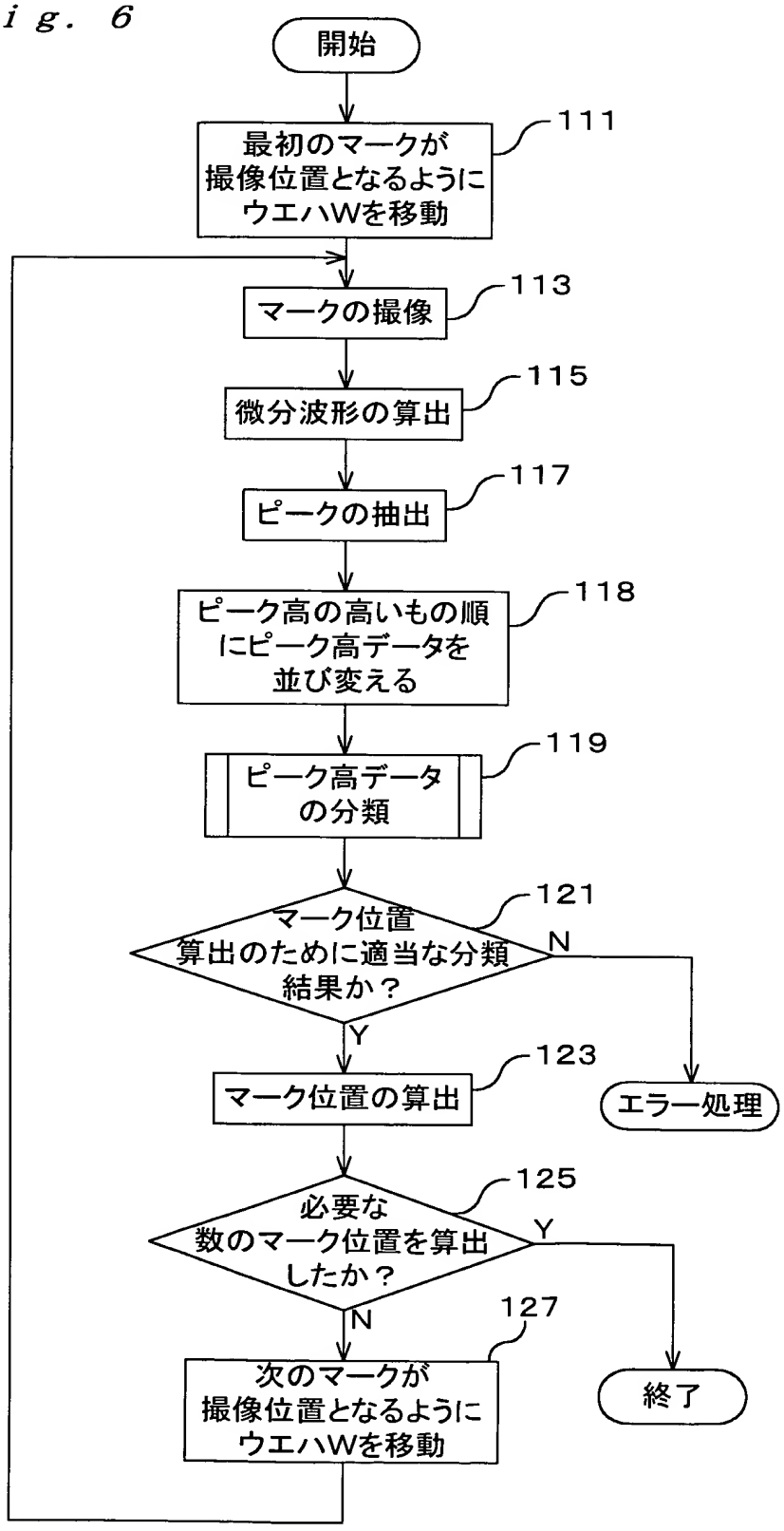

開始
最初のマークが撮像位置となるようにウエハWを移動
111
マークの撮像
113
微分波形の算出
115
ピークの抽出
117
ピーク高の高いもの順にピーク高データを並び変える
118
ピーク高データの分類
119
マーク位置算出のために適当な分類結果か？
121
N
Y
マーク位置の算出
123
エラー処理
必要な数のマーク位置を算出したか？
125
Y
N
次のマークが撮像位置となるようにウエハWを移動
127
終了

Fig. 7

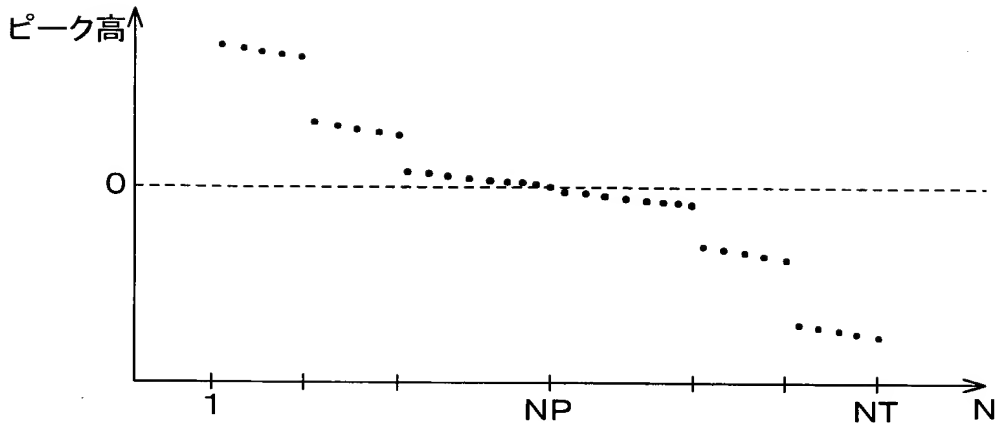


Fig. 8

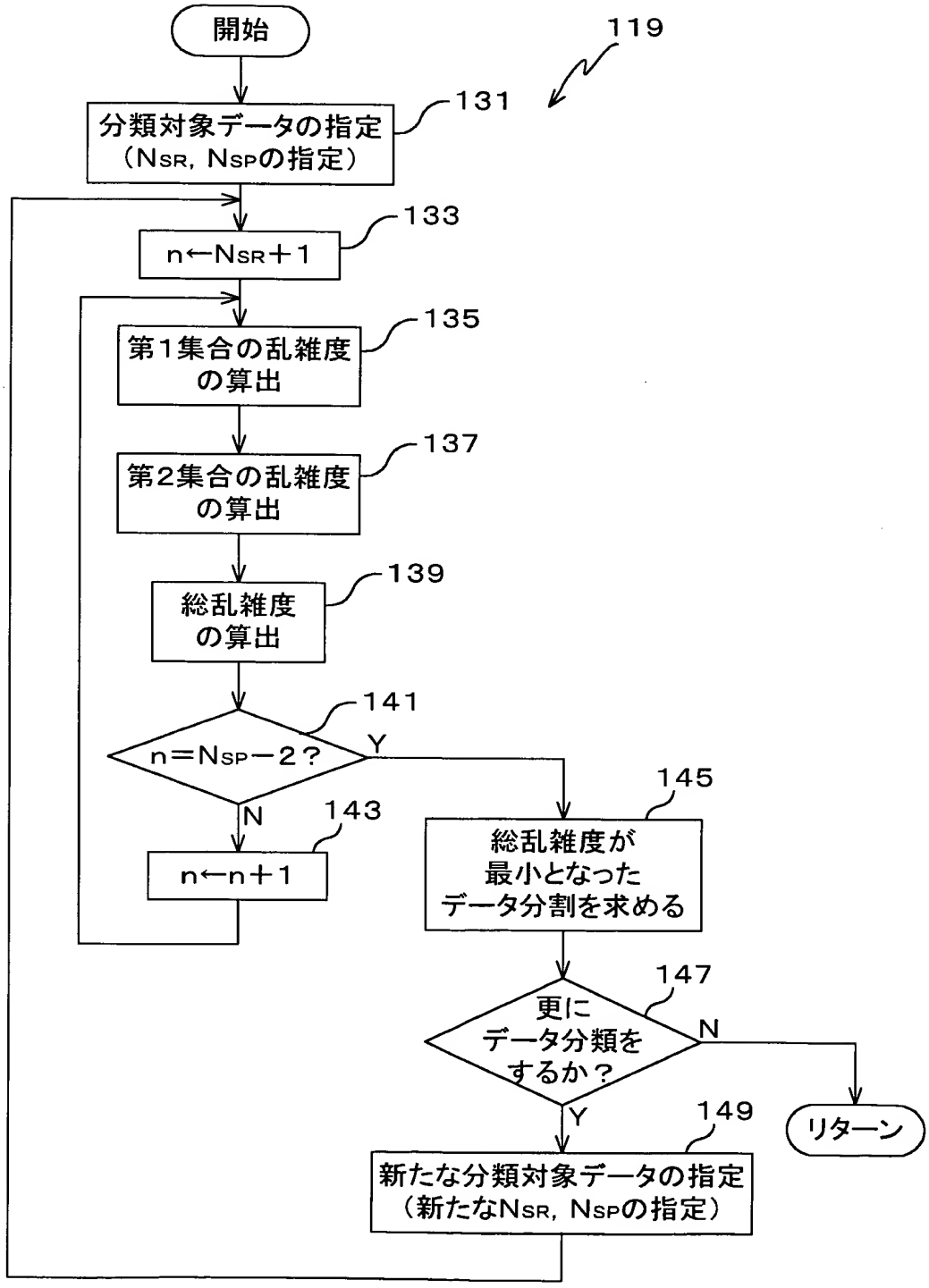

開始
119
分類対象データの指定
（NSR, NSPの指定）
131
n←NSR＋1
133
第1集合の乱雑度
の算出
135
第2集合の乱雑度
の算出
137
総乱雑度
の算出
139
n＝NSP－2？
141
Y
N
n←n＋1
143
総乱雑度が
最小となった
データ分割を求める
145
更に
データ分類を
するか？
147
N
Y
新たな分類対象データの指定
（新たなNSR, NSPの指定）
149
リターン

Fig. 9A

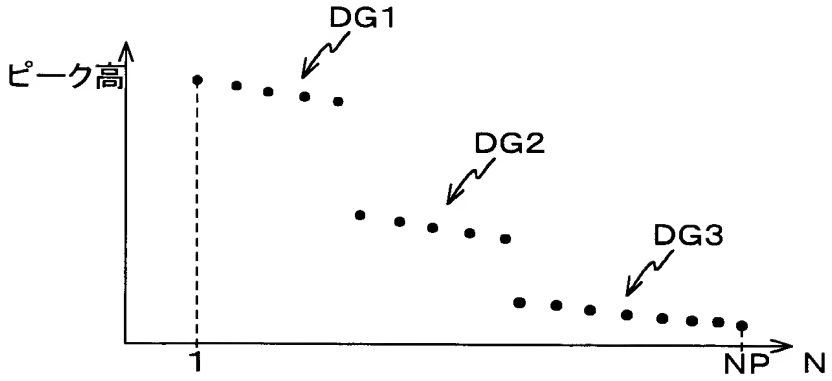


Fig. 9B

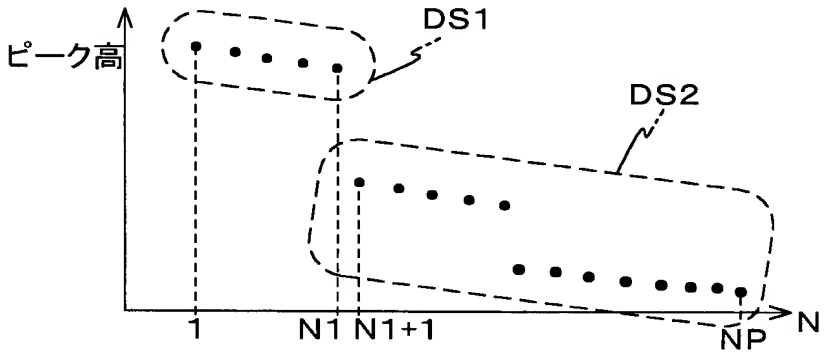
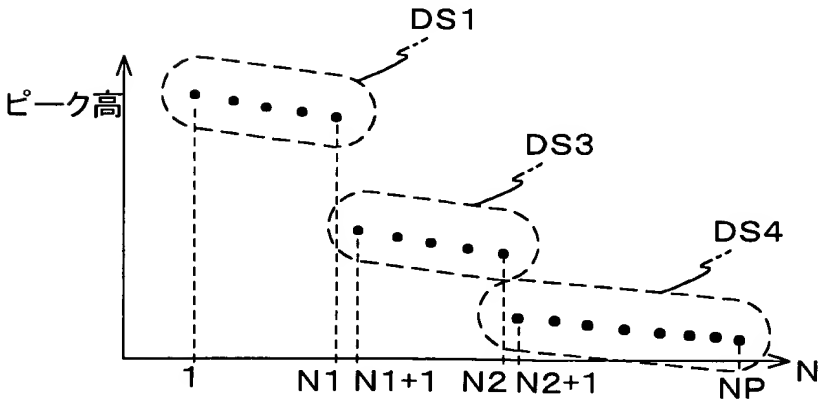


Fig. 9C



10／22

Fig. 10

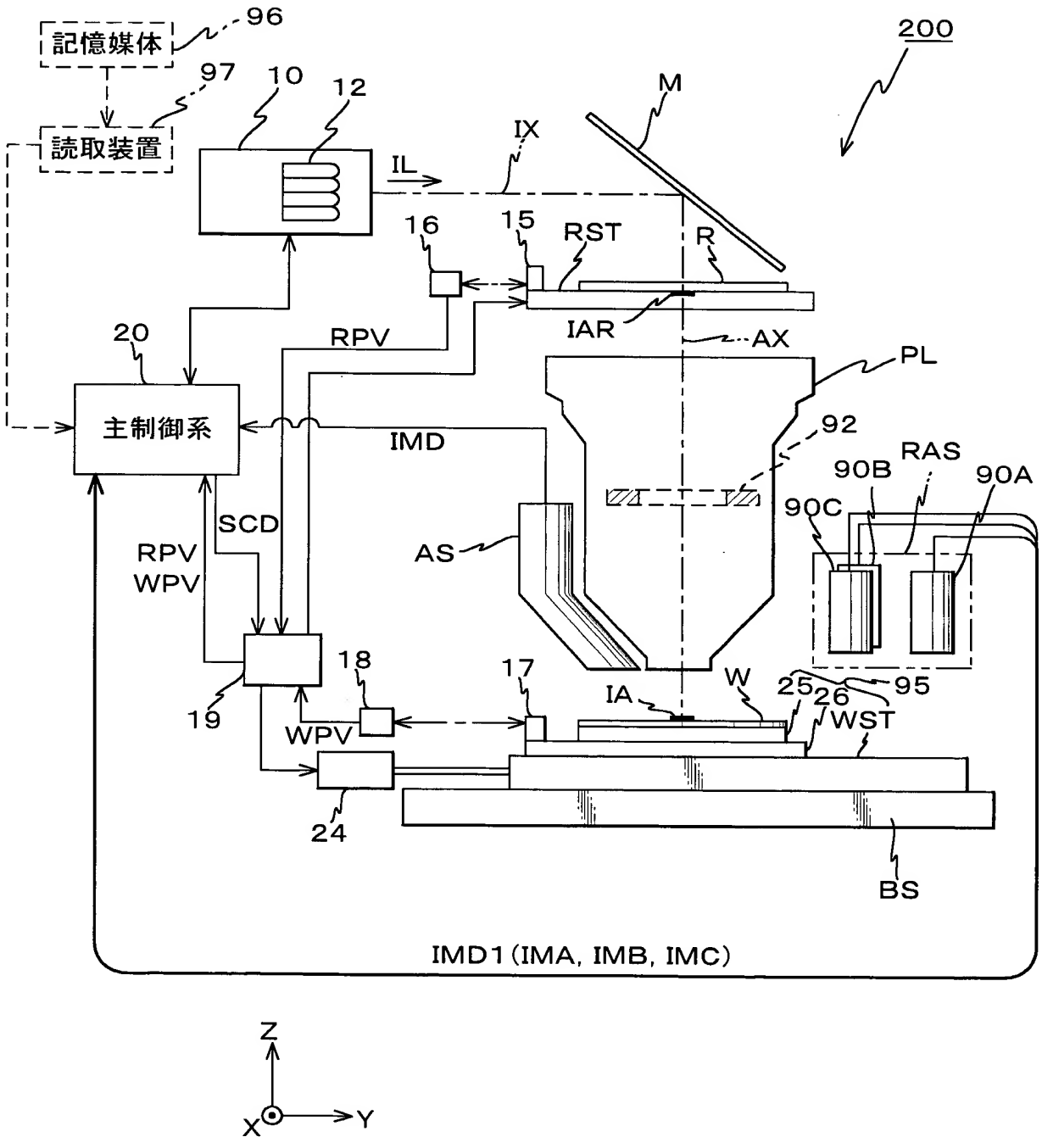

記憶媒体
96
97
読取装置
10
12
200
M
IX
IL
16
15
RST
R
IAR
AX
PL
20
RPV
主制御系
IMD
92
RAS
90B
90A
90C
SCD
RPV
WPV
AS
18
17
IA
W
25
26
95
WST
19
WPV
24
BS
IMD1 (IMA, IMB, IMC)
Z
X
Y

Fig. 11

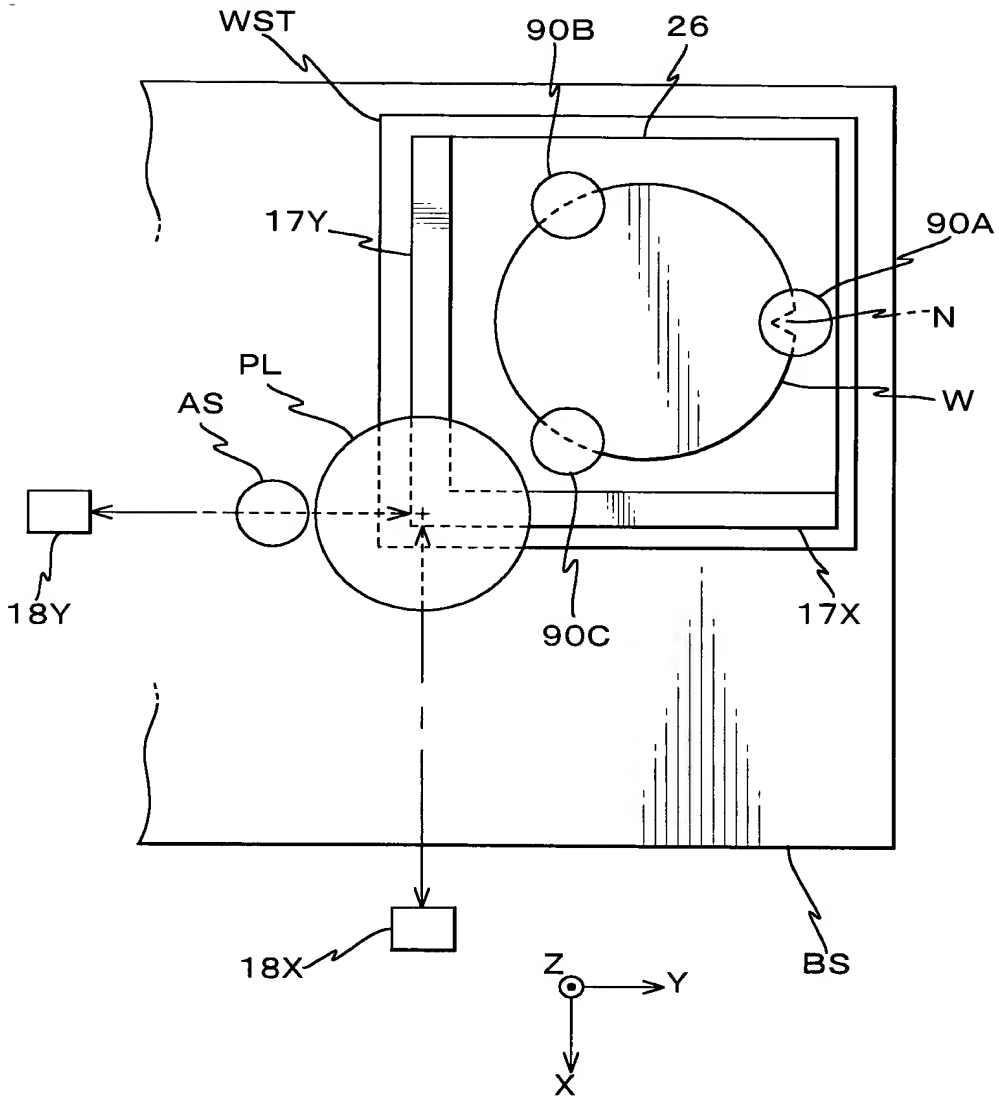
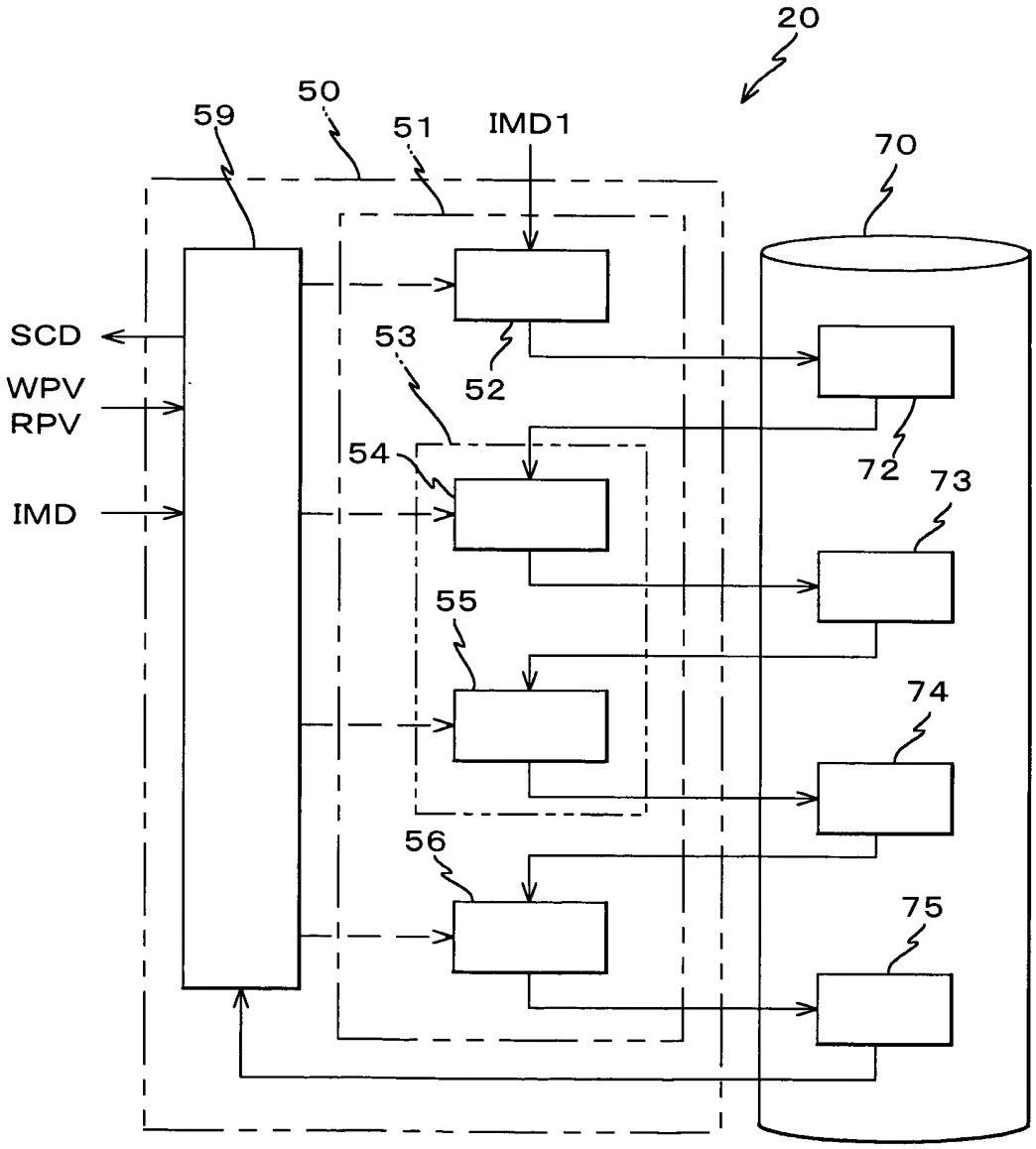


Fig. 12



Ｆｉｇ．１３

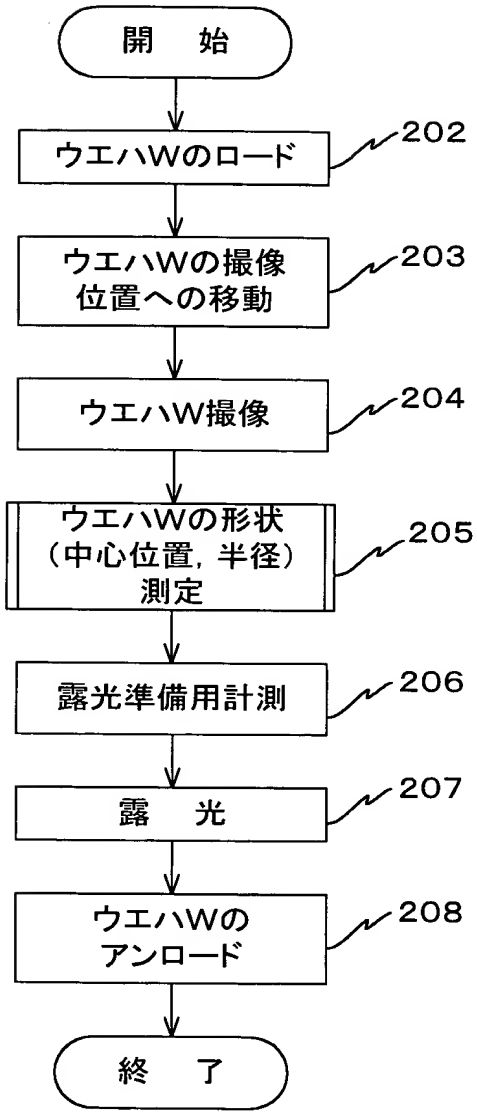
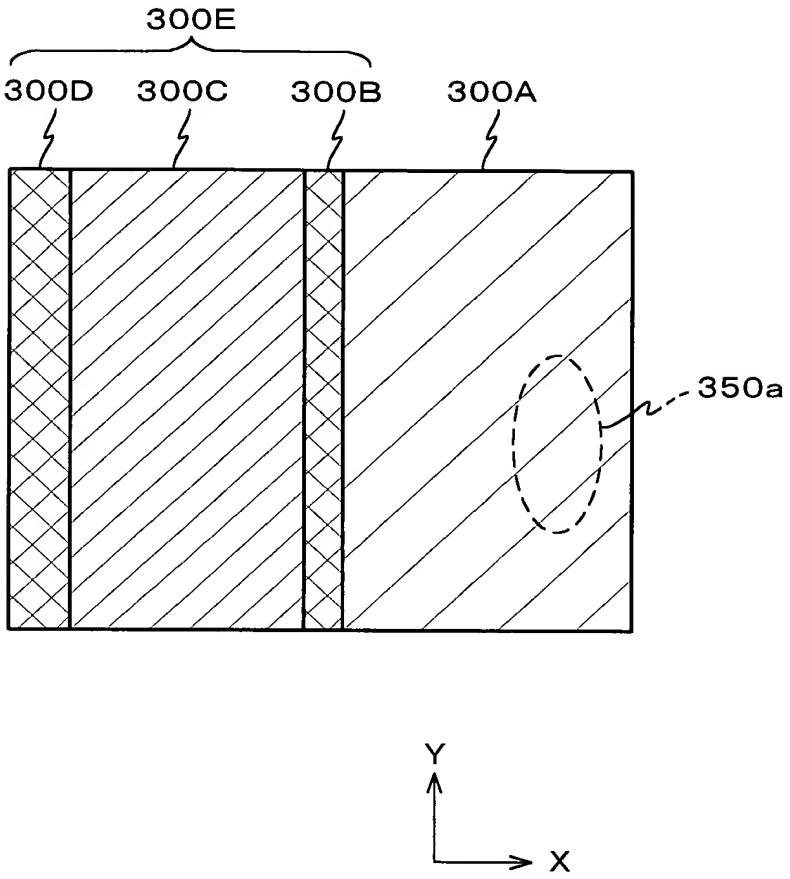

開　始
ウエハWのロード
202
ウエハWの撮像位置への移動
203
ウエハW撮像
204
ウエハWの形状（中心位置，半径）測定
205
露光準備用計測
206
露　光
207
ウエハWのアンロード
208
終　了

Fig. 14



Ｆｉｇ．１５

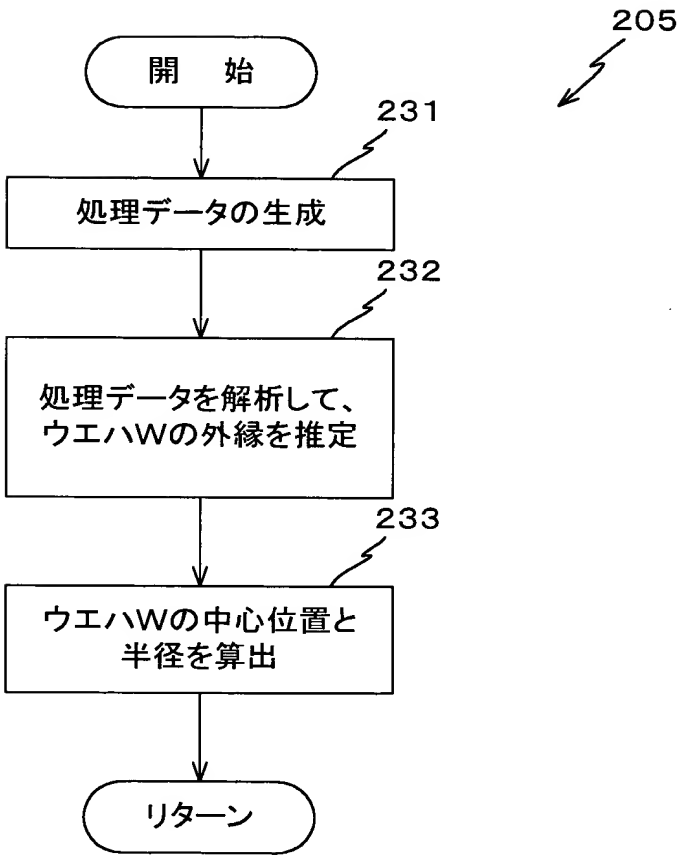


Fig. 16

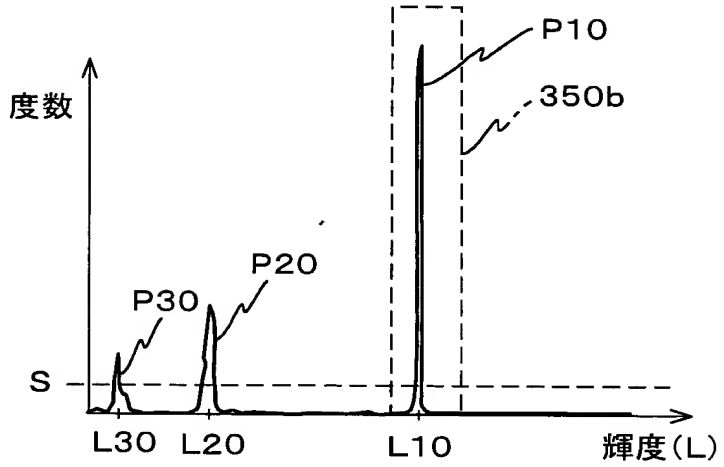


Fig. 17

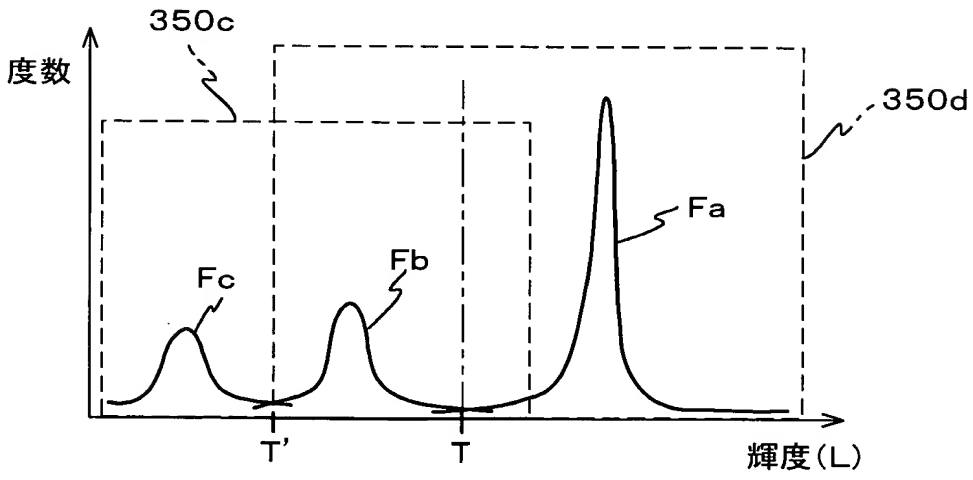


Fig. 18

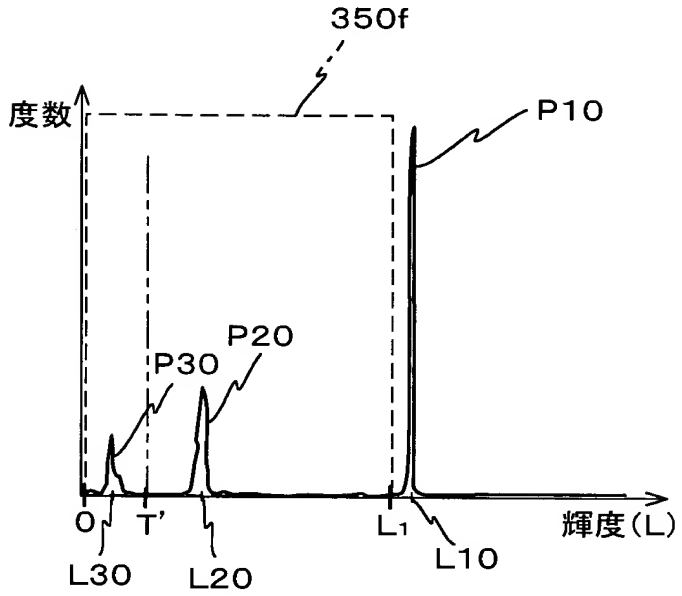

350f
度数
P10
P20
P30
0
T'
L1
輝度(L)
L30
L20
L10

Fig. 19

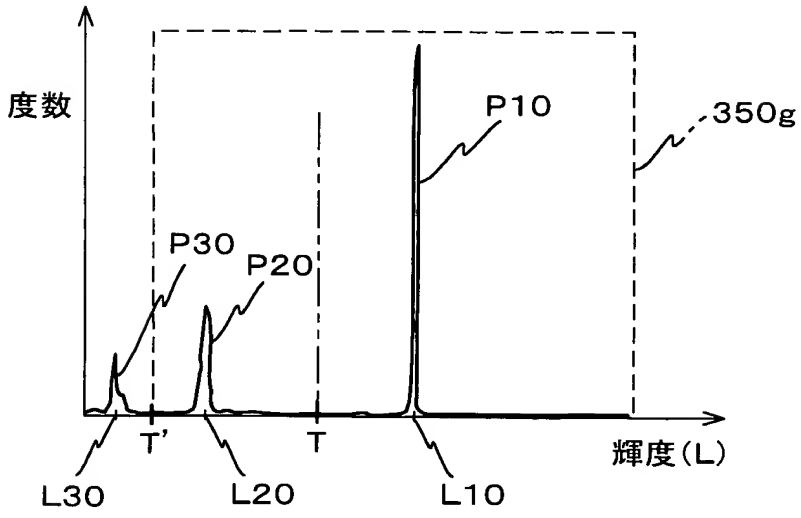

度数
P10
350g
P30
P20
T'
T
輝度(L)
L30
L20
L10

Fig. 20

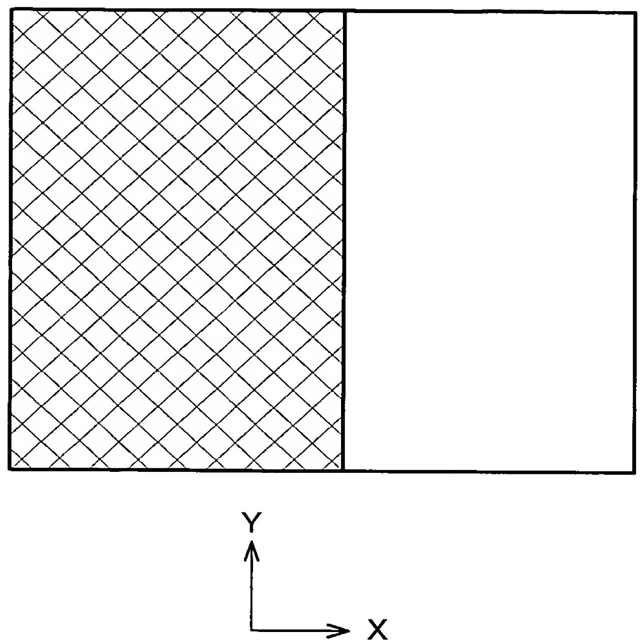


Fig. 21

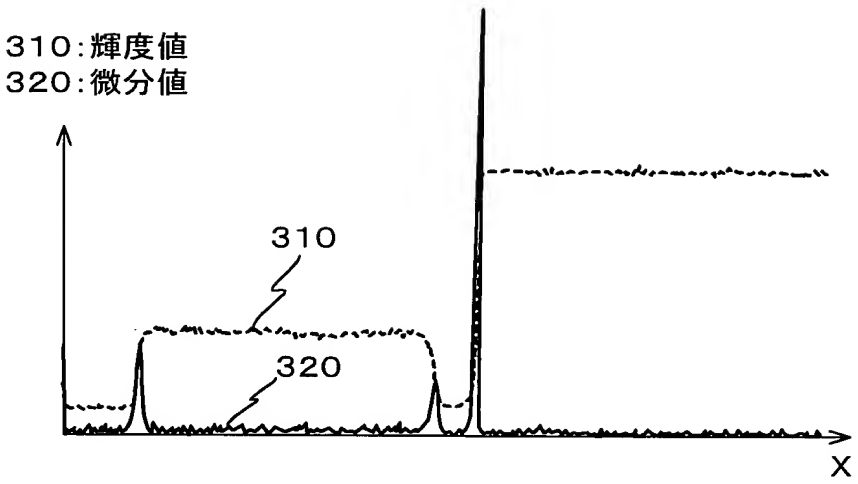


Fig. 22

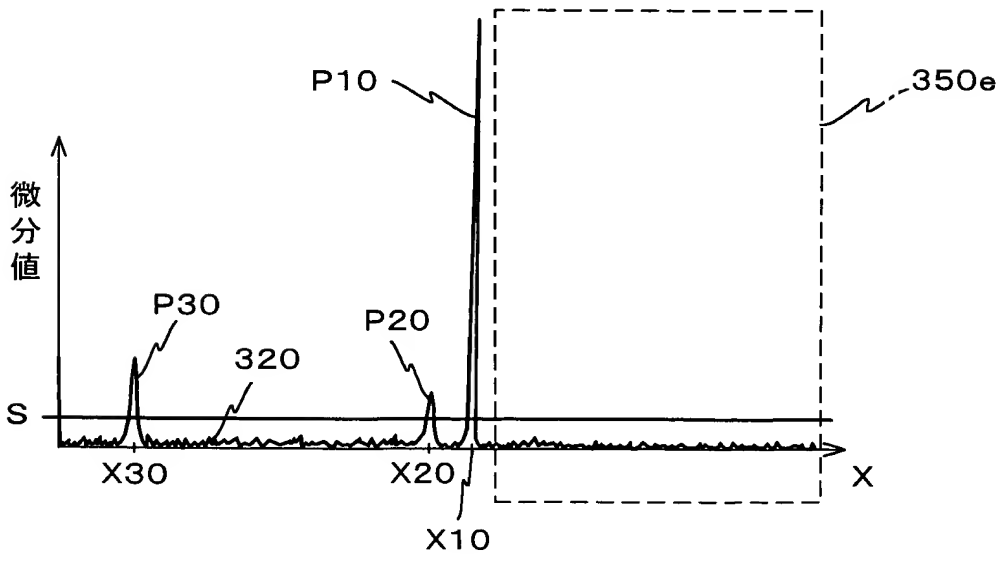


Fig. 23

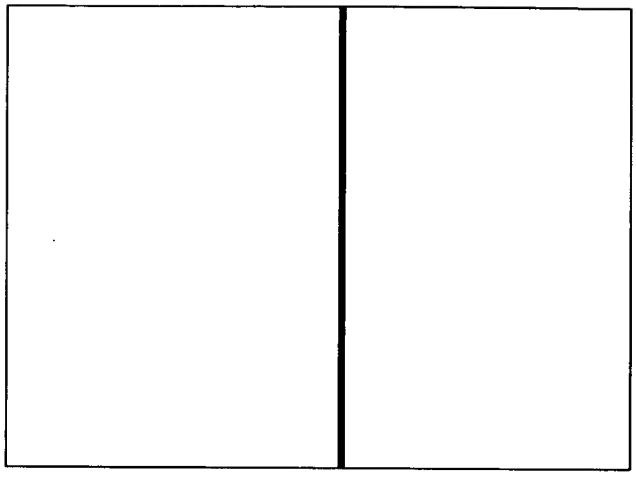


Fig. 24

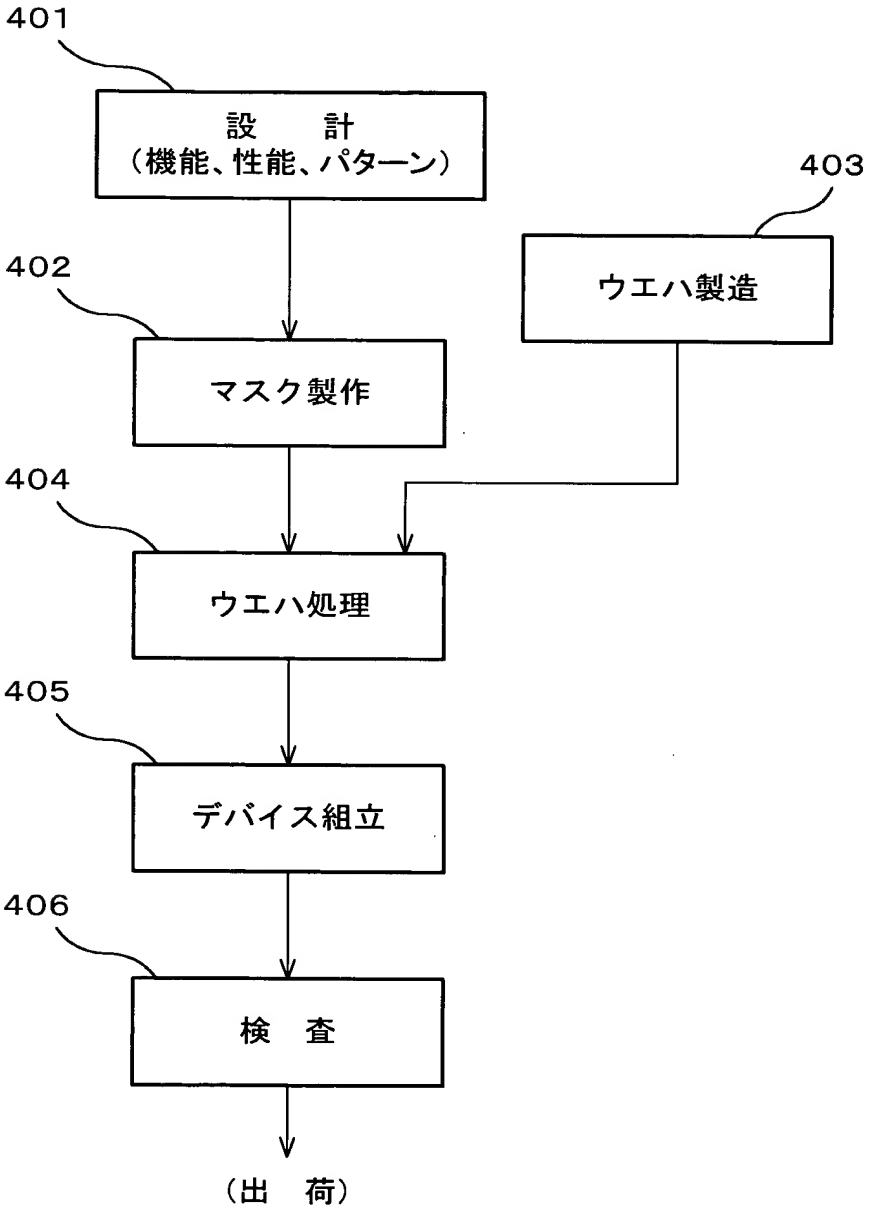
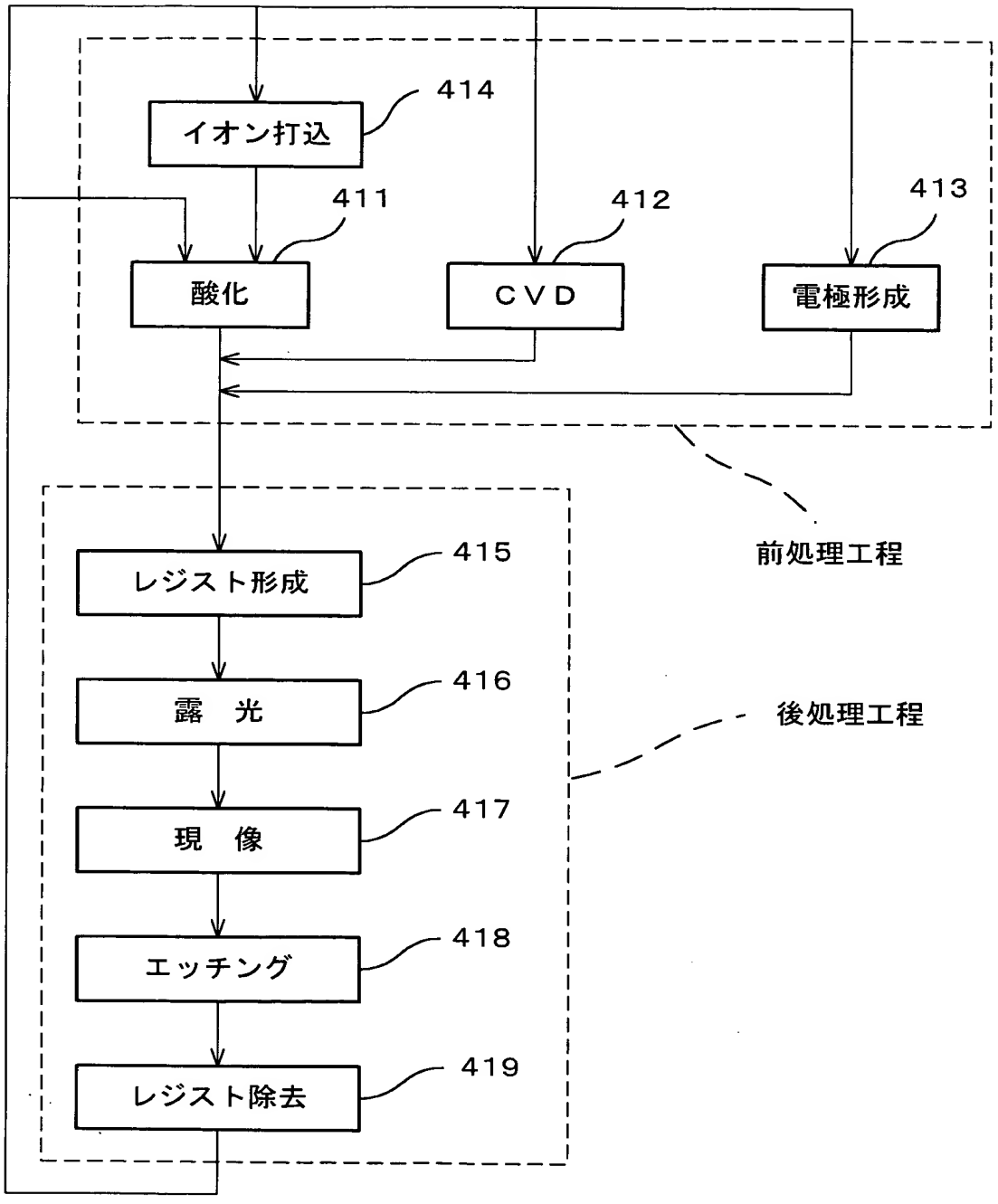

401
設　計
（機能、性能、パターン）
403
ウエハ製造
402
マスク製作
404
ウエハ処理
405
デバイス組立
406
検　査
（出　荷）

Fig. 25


414
イオン打込
411
412
413
酸化
CVD
電極形成
前処理工程
415
レジスト形成
416
露　光
後処理工程
417
現　像
418
エッチング
419
レジスト除去